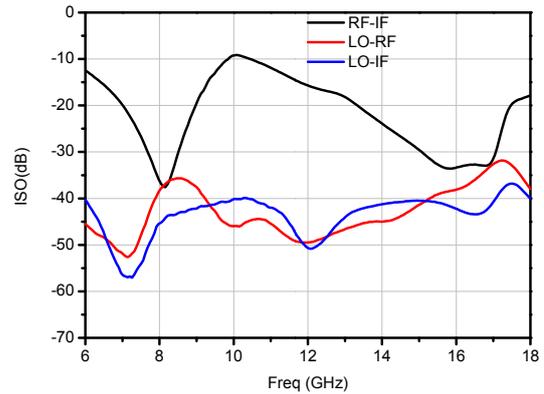


关键指标

射频&本振频率：6~18GHz
中频频率：DC~6GHz
本振功率：13dBm
变频损耗：7dB
LO/RF 隔离度：45dB
芯片尺寸：1.15mm×0.85mm×0.1mm

隔离度



产品简介

HG126HA 是一款无源双平衡混频器芯片，射频和本振频率为 6~18GHz，中频频率为 DC~6GHz，变频损耗为 7dB。

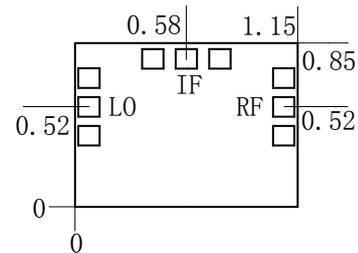
电性能 (T_A=25°C)

指标	最小值	典型值	最大值
RF&LO 频率(GHz)	6~18		
IF 频率(GHz)	DC~6		
变频损耗(dB)	—	7	—
LO~RF 隔离度(dB)	—	45	—
LO~IF 隔离度(dB)	—	45	—
RF~IF 隔离度(dB)	—	20	—

绝对额定最大值

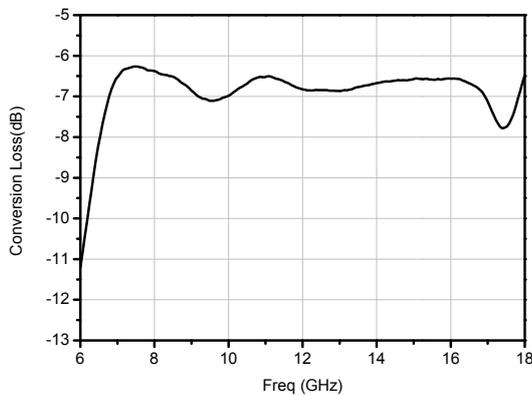
最大输入功率	+20dBm
工作温度	-55°C~125°C
存储温度	-65°C~150°C

外形和端口尺寸 (mm)



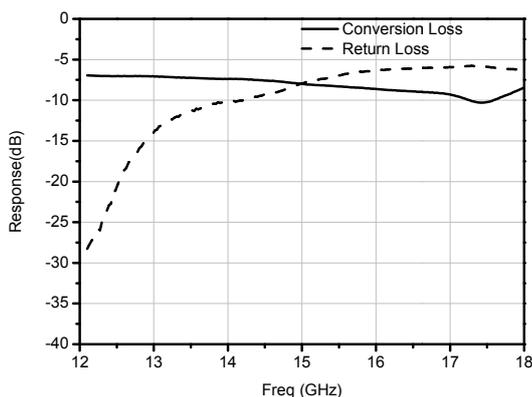
典型测试曲线

未注明情况下 IF=100MHz, LO=13dBm
变频损耗

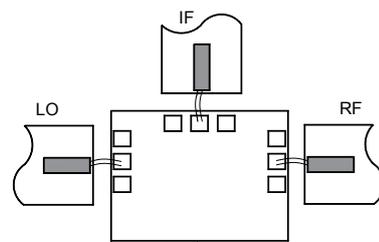


中频带宽

IF : 0.01-6GHz, RF: 12.1~18GHz, LO: 12GHz



推荐装配图



注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300°C，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用 Φ25μm 双金丝键合，建议金丝长度 250~400μm；
5. 微波端无隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。